

关键指标

频率: 7~13GHz
 饱和输出功率: 35dBm@Pin=15dBm
 功率附加效率: 30%@Pin=15dBm
 功率增益: 20dB@Pin=15dBm
 小信号增益: 22dB
 电压/静态电流: +8V/980mA, Vg:-0.6V
 芯片尺寸: 3mm×2mm

产品简介

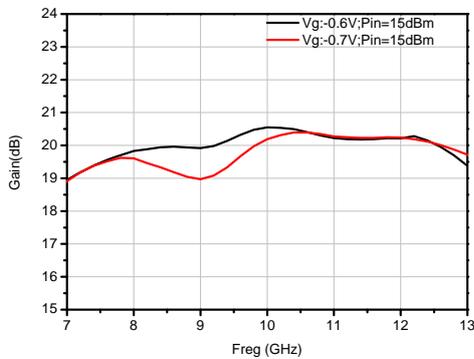
HG135F7 是一款 7~13GHz 功率放大器芯片, 饱和输出功率为 3W, 采用双电源供电, 输入输出端已集成隔直电容。

电性能 (TA=25°C, VD=8V, VG=-0.6V, Ids=980mA, 连续波)

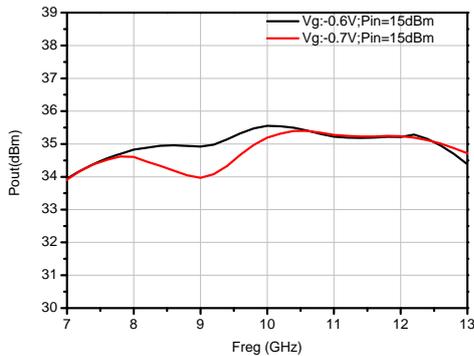
| 指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|-------------|------|-----|-----|
| 频率(GHz) | 7~13 | | |
| 功率增益(dB) | - | 20 | - |
| 饱和输出功率(dBm) | - | 35 | - |
| 功率附加效率(%) | - | 30 | - |
| 工作电流(A) | - | 1.4 | - |

典型测试曲线

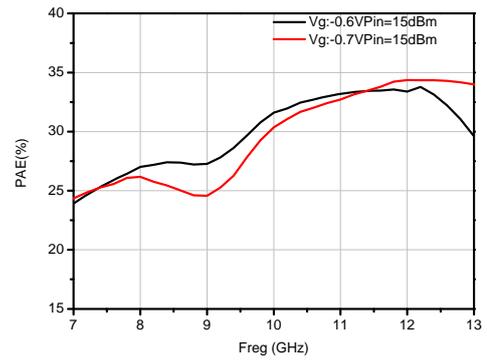
功率增益



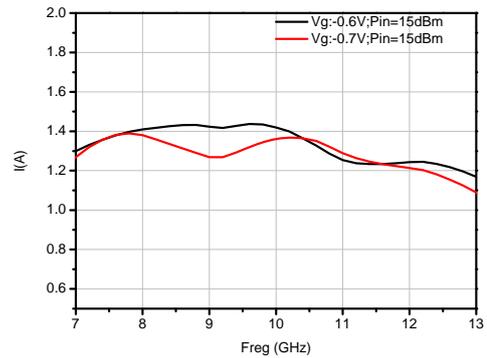
饱和输出功率



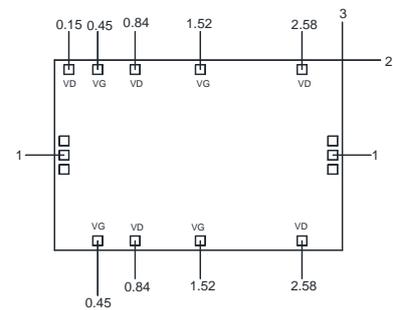
功率附加效率



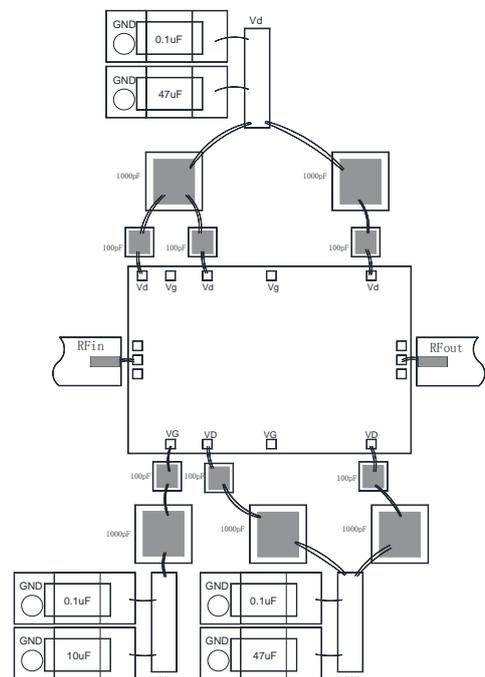
工作电流



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

| | |
|--------|-----------|
| 电源电压 | +10V |
| 最大输入功率 | +20dBm |
| 工作温度 | -55℃~85℃ |
| 存储温度 | -65℃~150℃ |

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 50μm 双金带键合，建议金带长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。